

⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

⑯ ⑯ **Offenlegungsschrift**  
⑯ ⑯ **DE 38 34 335 A1**

⑯ Int. Cl. 5:

**H01L 27/14**

H 01 L 27/15

H 01 L 23/52

G 02 B 6/12

⑯ ⑯ Anmelder:

TELEFUNKEN SYSTEMTECHNIK GMBH, 7900 Ulm,  
DE

⑯ ⑯ Erfinder:

Weidel, Edgar, Dipl.-Phys., 7913 Senden, DE

⑯ ⑯ Halbleiterschaltung

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung, bestehend aus einem elektrischen Teil, der z. B. in planarer CMOS- oder Bipolartechnik ausgeführt ist, und einer darauf befindlichen optischen Verbindungsschicht, die integrierte (Verbindungs-)Lichtwellenleiter enthält.

**DE 38 34 335 A1**

**DE 38 34 335 A1**

## Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterschaltung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Integrierte Halbleiterschaltungen bestehen aus einem (Halbleiter-)Substrat, z. B. seheibenförmigem, einkristallinem Silizium, mit einer Dicke von ungefähr 0,3 mm. Auf einer Oberflächenseite des Substrats ist in derzeit üblicher Halbleitertechnologie, z. B. Bipolar- oder CMOS-Technologie, eine Halbleiter-Schaltungsanordnung, z. B. bestehend aus Transistoren und Dioden, angeordnet. Auf dieser Halbleiter-Schaltungsanordnung befindet sich eine Leiterbahnschicht, die z. B. aus Aluminium-Leiterbahnen besteht. Die Leiterbahnschicht dient zum elektrischen Verbinden der beispielhaft erwähnten Transistoren und/oder Dioden. Eine derartige Anordnung wird auch als integrierte Schaltung (IS) bezeichnet. Komplexe Schaltungsanordnungen, wie z. B. Signalprozessoren oder Rechner, bestehen im allgemeinen aus einer größeren Anzahl derartiger Schaltungen (IS). Diese integrierten Schaltungen werden auf Karten, die z. B. aus Keramik oder einem Halbleitermaterial, z. B. Silizium, bestehen können, befestigt, z. B. durch Kleben und/oder Löten. Zwischen den integrierten Schaltungen werden über elektrische Leiterbahnen, die sich auf der Karte befinden, elektrische Verbindungen hergestellt.

Diese Karten werden dann in ein Gehäuse eingeschoben und über weitere elektrische Leiterbahnen in der Gehäuserückwand miteinander verbunden.

Die dabei benötigte Anzahl von elektrischen Verbindungsleitungen kann extrem groß sein. So kann ein Signalprozessor beispielsweise mehr als 100 integrierte Schaltungen enthalten, die viele tausende elektrischer Verbindungsleitungen erfordern. Die Taktraten heutiger Schaltungen liegen typisch bei 20 MHz. Um schnellere Signalprozessoren herzustellen, sind Taktraten von 100 MHz und mehr erforderlich. Mit zunehmenden Taktraten steigt jedoch die Gefahr eines störenden elektrischen Übersprechens zwischen parallelen oder sich kreuzenden Leitungen. Es erhöht sich damit die Wahrscheinlichkeit eines Bitfehlers.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Halbleiterschaltung anzugeben, welche eine hohe Packungsdichte elektronischer Bauelemente ermöglicht, welche eine hohe Datenübertragungsrate zwischen entfernt angeordneten Bauelementen und/oder Bauelementgruppen ermöglicht, welche eine möglichst geringe Fehlerwahrscheinlichkeit aufweist und welche kostengünstig und zuverlässig herstellbar ist.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und/oder Weiterbildungen sind den Unteransprüchen entnehmbar.

Ein erster Vorteil der Erfindung besteht darin, daß insbesondere für die Verbindung zwischen elektronischen Bauelementgruppen integrierte Lichtwellenleiter eingesetzt werden. Diese ermöglichen eine hohe Nachrichtenübertragungsrate und sind hochgenau herstellbar, z. B. mit Hilfe der Photolithographie und/oder der Ionenimplantationstechnologie.

Ein zweiter Vorteil besteht darin, daß der elektrische und der optische Teil der Halbleiterschaltung getrennt herstellbar und prüfbar sind. Dadurch können für jeden Teil optimale und daher kostengünstige und zuverlässige Herstellungsverfahren gewählt werden.

Ein dritter Vorteil besteht darin, daß bei dem elektri-

schen Teil der Halbleiterschaltung nahezu keine Bondverbindungen benötigt werden, so daß dieser Teil in planarer Halbleiter-Technologie ausführbar ist.

Die Erfindung wird im folgenden anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert unter Bezugnahme auf eine schematische Zeichnung. Dabei zeigen die

Fig. 1 bis 3 Schritte durch Ausführungsbeispiele.

Fig. 1 zeigt ein Substrat 1, z. B. eine derzeit in der Halbleitertechnologie übliche kreisförmige Silizium-Einkristallscheibe mit einer Dicke von ungefähr 0,3 mm bis 0,5 mm und einem Durchmesser von ungefähr 150 mm. Auf dieser befinden sich elektrische Leiterbahnen 3, die planar in derzeit üblicher Technologie hergestellt sind. Die Leiterbahnen 3 sind in einer Schicht enthalten, die aus vorzugsweise zwei Lagen metallischer Streifenleiter besteht, die durch dazwischenliegende dielektrische Isolierschichten getrennt sind. Neu ist, daß in dem Substrat 1 mindestens eine Aussparung oder Vertiefung 6 erzeugt ist, z. B. durch Ätzen, die so tief ist, daß darin mindestens ein elektro-optischer und/oder optoelektrischer Wandler 7, 7' sowie mindestens eine integrierte Schaltung 9 angeordnet werden können, z. B. durch Kleben oder Löten, derart, daß deren Oberflächen mit derjenigen der Leiterbahnschicht im wesentlichen eine Ebene bilden. Dann ist es möglich, die Wandler 7, 7' und die integrierte Schaltung mit Hilfe von Leiterbahnen 3 mit der Leiterbahnschicht elektrisch zu verbinden. In den Figuren bezeichnet 7 einen opto-elektrischen Wandler, z. B. eine Fotodiode, und 7' einen elektro-optischen Wandler, z. B. eine Laserdiode.

In der Vertiefung 6 können weitere Bauelemente angeordnet werden, z. B. ein elektrischer Multiplexer/Demultiplexer sowie Treiberschaltungen für die Wandler 7, 7'. Alle diese Bauelemente bilden im wesentlichen eine Ebene und werden elektrisch über die Leiterbahnschicht kontaktiert. Über der Leiterbahnschicht befindet sich mindestens eine optische Verbindungsschicht 4, z. B. eine Glasplatte mit einer Dicke von ungefähr 0,3 mm bis 2 mm. In dieser befindet sich mindestens ein vorzugsweise in optisch integrierter Weise hergestellter Lichtwellenleiter 5, der z. B. mit Hilfe derzeit üblicher photolithographischer Verfahren sowie eines daran anschließenden Ionenaustauschverfahrens hergestellt ist. Der Lichtwellenleiter 5 besitzt z. B. eine quadratische Querschnittsfläche des Kerns mit einer Seitenlänge von ungefähr 40 µm. Die Verbindungsschicht 4 kann aber auch aus Kunststoff bestehen, in welcher Kunststoff-Lichtwellenleiter vorhanden sind. In der Verbindungsschicht 4 sind außerdem un- und/oder halbdurchlässige Umlenkspiegel 8 vorhanden, über welche die Wandler 7, 7' optisch an den Lichtwellenleiter 5 koppelbar sind, z. B. mit Hilfe weiterer Umlenkspiegel 8', die in dem Substrat 1 angeordnet sind. Alle Umlenkspiegel 8, 8' sind durch physikalische und/oder chemische Verfahren herstellbar, z. B. durch Prägen, Fräsen, Schleifen, Polieren und/oder Ätzen.

Anschließend daran können die Umlenkspiegel 8, 8' noch mit optisch wirksamen Schichten beschichtet werden, z. B. halbdurchlässigen oder total reflektierenden Schichten. Dieser Beschichtungsvorgang kann z. B. im Vakuum mit Hilfe eines Schrägbedämpfungsverfahrens erfolgen. Eine solche Verbindungsschicht 4 wird dann auf der Leiterbahnschicht oder einer darüber befindlichen Schutzschicht, z. B. einer Oxidschicht, derart befestigt, z. B. durch Kleben, daß die Umlenkspiegel 8 der Leiterbahnschicht zugewandt sind und sich über den optischen Ein- und/oder Austrittsöffnungen der Wandler 7, 7' befinden. Es ist selbstverständlich, daß in der

Leiterbahnschicht entsprechende Öffnungen vorhanden sind. Eine derartige Anordnung ermöglicht, daß das von dem Wandler 7', z. B. einem Halbleiterlaser, ausgesandte Licht 10, das z. B. so moduliert ist, daß eine Nachrichtenübertragungsrate bis ungefähr 2 GBit/s möglich ist, in den in der Verbindungsschicht 4 befindlichen Lichtwellenleiter eingekoppelt wird und dort über relativ weite Entferungen, z. B. einige cm, was durch die Unterbrechung dargestellt ist, zu dem in Fig. 1, rechts dargestellten Wandler 7 übertragen werden kann. Die entstehenden elektrischen Signale werden über elektrische Leiterbahnen 3 zu einer integrierten Schaltung 9, z. B. einem Demultiplexer, übertragen und dann weiterverarbeitet.

Der Lichtwellenleiter 5 kann z. B. so dimensioniert sein, daß darin eine optische Wellenlängenmultiplex-Übertragung in entgegengesetzten Richtungen möglich ist. Dieses ist durch die Doppelpfeile dargestellt. Weiterhin ist es möglich, z. B. durch Ionenimplantation, in dem Substrat 1 ebenfalls einen Lichtwellenleiter 5 zu erzeugen und darin Licht 10 zu übertragen. Außerdem kann auch unterhalb des Substrates 1 mindestens eine Verbindungsschicht, in der sich mindestens ein Lichtwellenleiter 5 befindet, angebracht sein.

Wird ein elektro-optischer Wandler 7' verwandt, der Licht senkrecht zur Oberfläche des Substrates 1 aussendet, so kann der Umlenkspiegel 8' entfallen.

Weiterhin kann in dem Substrat 1 zusätzlich eine schichtförmige Halbleiter-Schaltungsanordnung 2, die z. B. in Bipolarechnologie ausgeführt ist, vorhanden sein.

Fig. 2 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel. Das Substrat 1 weist keine Vertiefungen auf, sondern eine vorzugsweise ebene Oberfläche. Die elektrischen Leiterbahnen 3 befinden sich auf einem Substrat 1', das vorzugsweise aus Si besteht und mit dem Substrat 1 befestigt ist, beispielsweise durch Löten, Schweißen, Kleben, Bonden oder anodischem Boden. Die Höhe des Substrates 1' der opto-elektrischen Wandler 7, 7' und der integrierten Schaltungen 9 ist gleich groß mit zulässigen Abweichungen von maximal etwa 20 µm. Das Substrat 1' weist Aussparungen 6 auf, in denen die Wandler 7, 7' und die Schaltungen 9 untergebracht sind. Im Gegensatz zu Fig. 1 erstrecken sich die elektrischen Leiterbahnen 3 auch nicht über die gesamte Fläche der integrierten Schaltungen 9, sondern nur bis zu Kontaktstellen in den Randbereichen.

Kombinationen entsprechend Fig. 1 und Fig. 2 sind ebenfalls ausführbar.

Fig. 3 zeigt ein Ausführungsbeispiel, in dem mehrere Anordnungen gemäß Fig. 1 und/oder Fig. 2 optisch koppelbar sind. Dieses erfolgt mit Hilfe einer optischen Leiterplatte 11, z. B. ebenfalls einer Glas- oder Kunststoffplatte, in der sich mindestens ein Lichtwellenleiter 5' sowie un- und/oder halbdurchlässige Umlenkspiegel befinden. Die Leiterplatte 11 ist im wesentlichen senkrecht zu mehreren parallel stehenden Anordnungen gemäß Fig. 1 und Fig. 2 so angeordnet, daß die in der Leiterplatte 11 befindlichen Umlenkspiegel das in dem Lichtwellenleiter 5' befindliche Licht 10 in die Lichtwellenleiter 5 koppeln.

Eine weitere zusätzliche oder alternative Möglichkeit der optischen Kopplung zwischen mehreren Anordnungen gemäß Fig. 1 ist in dem oberen Teil der Fig. 3 dargestellt. Dort sind zwei Anordnungen gemäß Fig. 1 parallel so angeordnet, daß sich ihre Verbindungsschichten 4 gegenüber liegen. Diese können in der dargestellten Weise einen Abstand voneinander besitzen oder sich

berühren und/oder zusammengefügt sein, z. B. mit einem Kleber. Das von einem Wandler 7' ausgesandte Licht (Pfeile) wird z. B. über eine in der Verbindungsschicht enthaltene abbildende Optik 13, z. B. diffundierte Konvexlinsen, in einen Lichtweg 12, z. B. ebenfalls einen Lichtwellenleiter, gekoppelt, der senkrecht durch die zwei Verbindungsschichten läuft und an dessen andrer Ende sich ein opto-elektrischer Wandler, z. B. eine Photodiode, befindet.

Weiterhin ist es möglich, die Optik 13 an den Randbereich des Substrates zu legen und damit mehrere Anordnungen entsprechend den Fig. 1 und 2 zu koppeln.

Die beschriebenen Anordnungen ermöglichen vorteilhafterweise, die Vorteile einer integrierten elektrischen Schaltung mit denjenigen einer integrierten optischen Schaltung zu kombinieren. Damit lassen sich z. B. sehr schnelle Höchstleistungsrechner herstellen, da einerseits eine hohe Packungsdichte elektrischer Bauelemente möglich ist und andererseits eine hohe Datenübertragungsrate zwischen verschiedenen Schaltungsanordnungen ermöglicht wird.

Die Erfindung ist nicht auf die beschriebenen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern sinngemäß auf weitere anwendbar. So können beispielsweise die Verbindungsschichten optische Schalter und/oder optische Multiplexer und/oder Demultiplexer enthalten und/oder mit diesen und/oder weiteren Einzel-Lichtwellenleitern, z. B. einem sehr langen Monomode-Lichtwellenleiter, gekoppelt sein.

#### Patentansprüche

1. Halbleiterschaltung, bestehend aus einem Substrat, auf dem mindestens eine integrierte Schaltung und mehrere elektrische Leiterbahnen angeordnet sind, **dadurch gekennzeichnet**, daß in mindestens einer optischen Verbindungsschicht (4) und/oder innerhalb des Substrates (1) mindestens ein Lichtwellenleiter (5) vorhanden ist, daß sich in einer Aussparung oder Vertiefung (6) des Substrates (1) mindestens ein elektro-optischer und/oder ein opto-elektrischer Wandler (7, 7') befindet, der optisch an den Lichtwellenleiter (5) angekoppelt ist und der elektrisch mit der integrierten Schaltung (9) verbunden ist und daß die Verbindungsschicht (4) oberhalb der Leiterbahnen (3) sowie der integrierten Schaltung (9) und/oder unterhalb des Substrates (1) angeordnet ist.
2. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest in der Verbindungsschicht (4) mindestens ein Umlenkspiegel (8), über welchen der Wandler (7, 7') und der Lichtwellenleiter (5) optisch koppelbar sind, vorhanden ist.
3. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Wandler (7') als lichtemittierendes Halbleiterbauelement, das Licht im wesentlichen parallel zur Oberfläche des Substrates (1) aussendet, ausgebildet ist und daß in dem Substrat (1) und der Verbindungsschicht (4) jeweils ein Umlenkspiegel (8, 8'), über welchen der Wandler (7) an den Lichtwellenleiter (5) optisch koppelbar ist, vorhanden ist.
4. Halbleiterschaltung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, daß der Wandler (7') als lichtemittierendes Bauelement, das Licht im wesentlichen senkrecht zur Oberfläche des Substrates (1) aussendet, ausgebildet ist und daß sich in der Verbindungsschicht (4) ein Umlen-

spiegel (8) befindet, über welchen das Licht in den  
Lichtwellenleiter (5) einkoppelbar ist.  
5. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  
zumindest ein in dem Substrat (1) befindlicher Um- 5  
lenkspiegel (8') als kristallographische Fläche aus-  
gebildet ist.  
6. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  
die Verbindungsschicht (4) aus Glas und/oder 10  
Kunststoff besteht und daß die darin befindlichen  
Umlenkspiegel (8) durch eine physikalische und/  
oder chemische Behandlung hergestellt sind.  
7. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß 15  
mindestens zwei Verbindungsschichten (4), die ver-  
schiedenen Substraten (1) zugeordnet sind, durch  
eine optische Leiterplatte (11), die mindestens ei-  
nen Lichtwellenleiter (5') enthält, optisch gekoppelt  
sind (Fig. 3). 20  
8. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  
die Leiterplatte (11) aus Glas oder Kunststoff oder  
Halbleitermaterial aus einer Kombination dieser  
Materialien besteht. 25  
9. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  
die optische Kopplung von mindestens zwei Licht-  
wellenleitern und/oder von mindestens zwei Wand-  
lern durch mindesten einen Lichtweg (12) erfolgt, 30  
der eine abbildende Optik (13) enthält.  
10. Halbleiterschaltung nach einem der vorherge-  
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß  
die Optik (13) als integrierte Optik ausgebildet ist. 35

---

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

40

45

50

55

60

65

— Leerseite —

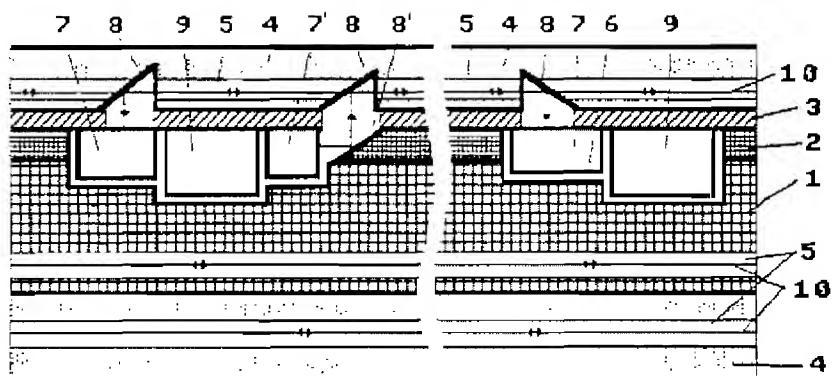


Fig. 1

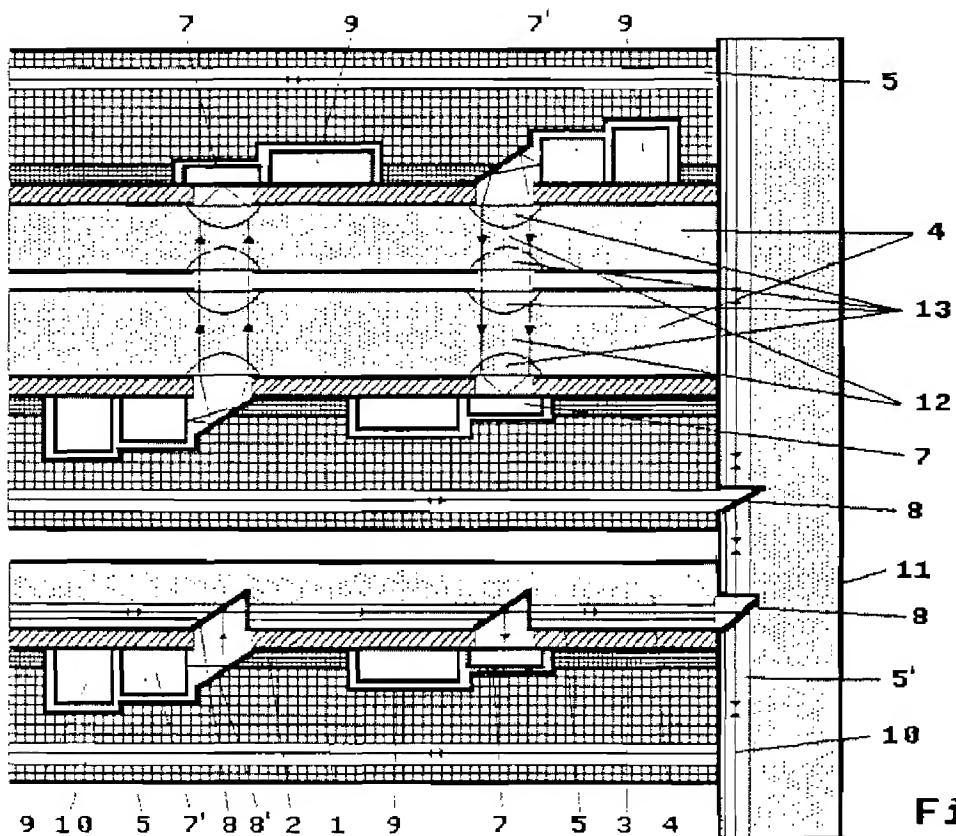


Fig. 3

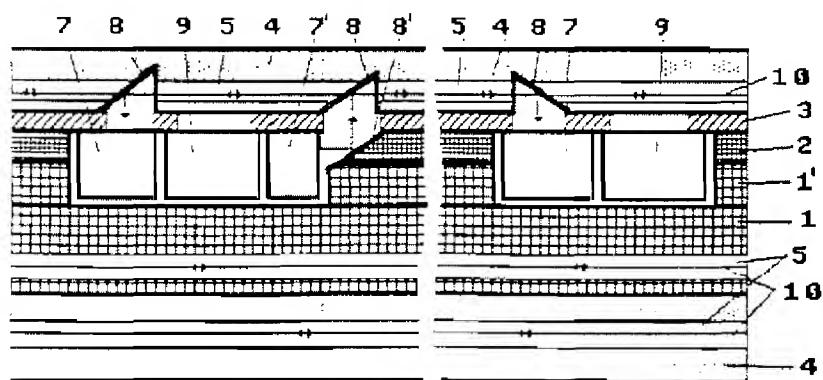


Fig. 2